

令和7年4月21日

委員各位

応用物理学会  
半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会  
委員長 小椋 厚志

半導体の結晶成長と加工および評価に関する産学連携委員会  
第10回研究会開催通知

日時： 2025年6月27日（金）13:00～17:30

場所： 明治大学駿河台キャンパス グローバルフロント1階 多目的室

テーマ：「ワイドギャップ酸化物半導体  $\text{Ga}_2\text{O}_3$  の成長、評価、およびデバイス応用の新展開」

世話人：太子 敏則（信州大）、上田 修（明治大）

プログラム（講演題目は仮題）：

- 13:00～13:05 開会の挨拶 小椋 厚志（明治大）
- 13:05～13:10 はじめに 太子 敏則（信州大）
- 13:10～13:50 水冷銅坩堝を用いた $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ バルク単結晶の融液成長法の開発  
吉川 彰（東北大、(株) FOX、(株) C&A）、V. V. Kochurikhin（(株) FOX）、  
富田 健稔（(株) FOX、(株) C&A）、北原 正典（東北大、(株) FOX、(株) C&A）、  
姚 永昭（三重大）、鎌田 圭（東北大、(株) FOX、(株) C&A）、  
庄子 育宏（(株) FOX、(株) C&A）、柿本 浩一（東北大）
- 13:50～14:30 垂直ブリッジマン(VB)法による $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 単結晶育成と線状ボイドの評価  
太子 敏則、宮城 右京、干川 圭吾（信州大）
- 14:30～15:10  $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ のHVPE、MOCVD成長とパワーデバイス応用  
佐々木 公平、倉又 朗人（(株)ノベルクリスタルテクノロジー）
- 15:10～15:25 休憩
- 15:25～16:05 ミストCVD成長 $\alpha\text{-(Al, Ga)}_2\text{O}_3$ 薄膜のフォトニクス応用 神野 莉衣奈（東大）
- 16:05～16:45  $\beta\text{-Ga}_2\text{O}_3$ 薄膜のMBE成長と横型高周波トランジスタの開発  
大槻 匠、上村 崇史（情報通信研究機構）、東脇 正高（大阪公立大）
- 16:45～17:25 ミストCVDによる $\text{Ga}_2\text{O}_3$ の結晶多形制御とデバイス応用  
西中 浩之（京都工繊大）
- 17:25～17:30 おわりに 上田 修（明治大）
- 18:00～20:00 意見交換会(明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント 17階  
グローバルラウンジ)

以上